

Silicon Diode

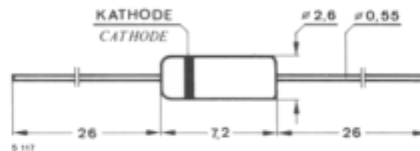
BA147/25

25V / 150mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

BA 147/...**Silizium-Diode**
Silicon diode**Anwendungen:** Allgemein**Applications:** General purpose**Abmessungen in mm**
Dimensions in mm

Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	BA 147/25 BA 147/50 BA 147/100 BA 147/150 BA 147/230 BA 147/300	U_R U_R U_R U_R U_R U_R	25 50 100 150 230 300	V V V V V V
Periodischer Durchlaßspitzenstrom Repetitive peak forward current		I_{FRM}	500	mA
Durchlaßstrom Forward current		I_F	150	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature		t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range		t_{stg}	-55...+150	°C

BA 147/...

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA}

500 °C/W

Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 50 \text{ mA}$

U_F

1

V

Sperrstrom

Reverse current

$U_R = 25 \text{ V}$ BA 147/25

I_R

500

nA

$U_R = 50 \text{ V}$ BA 147/50

I_R

500

nA

$U_R = 100 \text{ V}$ BA 147/100

I_R

1

μA

$U_R = 150 \text{ V}$ BA 147/150

I_R

1,5

μA

$U_R = 230 \text{ V}$ BA 147/230

I_R

2

μA

$U_R = 300 \text{ V}$ BA 147/300

I_R

3

μA

$t_j = 100^\circ\text{C}$

$U_R = 10 \text{ V}$ BA 147/25, BA 147/50

I_R

15

μA

$U_R = 50 \text{ V}$ BA 147/100

I_R

30

μA

$U_R = 100 \text{ V}$ BA 147/150

I_R

50

μA

$U_R = 150 \text{ V}$ BA 147/230

I_R

75

μA

$U_R = 200 \text{ V}$ BA 147/300

I_R

100

μA

BA 147/ ...

